

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 6 部門第 4 区分
 【発行日】平成 18 年 3 月 2 日 (2006.3.2)

【公開番号】特開 2005-100526 (P2005-100526A)
 【公開日】平成 17 年 4 月 14 日 (2005.4.14)
 【年通号数】公開・登録公報 2005-015
 【出願番号】特願 2003-332657 (P2003-332657)
 【国際特許分類】

G 1 1 B 7/26 (2006.01)

G 1 1 B 7/243 (2006.01)

G 1 1 B 7/24 (2006.01)

【F I】

G 1 1 B 7/26 5 0 1

G 1 1 B 7/24 5 1 1

G 1 1 B 7/24 5 3 5 D

【手続補正書】
 【提出日】平成 18 年 1 月 16 日 (2006.1.16)
 【手続補正 1】
 【補正対象書類名】特許請求の範囲
 【補正対象項目名】全文
 【補正方法】変更
 【補正の内容】
 【特許請求の範囲】
 【請求項 1】

結晶領域と、アモルファス領域とを有する、Ge、In、Sb、Teの少なくとも 1 種類を含むデバイスに対し、前記結晶領域と前記アモルファス領域の何れか一方を、純水或いはアルカリ溶液を用いて、選択的に除去することにより、凹凸形状を形成することを特徴とするデバイスの製造方法。

【請求項 2】

前記結晶領域と前記アモルファス領域は、エネルギー照射によって形成され、前記アモルファス領域は、融解することによって形成されることを特徴とする請求項 1 記載のデバイスの製造方法。

【請求項 3】

前記結晶領域と前記アモルファス領域は、エネルギー照射によって形成され、前記エネルギーは、電子線、電流の少なくともいずれかであることを特徴とする請求項 1 記載のデバイスの製造方法。

【請求項 4】

前記デバイスは、基板と、下部保護層と、相変化膜とを有し、前記前記結晶領域と前記アモルファス領域は、前記相変化膜に形成されることを特徴とする請求項 1 記載のデバイスの製造方法。

【請求項 5】

結晶領域と、アモルファス領域とを有する Ge、In、Sb、Te の少なくとも 1 種類を含むデバイスに対し、前記結晶領域と前記アモルファス領域の何れか一方を、純水或いはアルカリ溶液を用いて、選択的に除去することにより、凹凸形状を形成し、前記凹凸形状を有するデバイスを観察することを特徴とする観察方法。

【請求項 6】

基板と、相変化膜とを有するデバイスに対し、エネルギーを照射して、前記相変化膜の所定の領域を融解させ、前記融解させた領域内で、アモルファス領域と再結晶化領域を生

成する工程と、

前記アモルファス領域と前記再結晶化領域の何れか一方を、純水或いはアルカリ溶液を用いて、選択的に除去することにより、凹凸形状を形成することを特徴とするデバイスの製造方法。

【請求項 7】

前記再結晶化領域は、前記アモルファス領域の周囲に形成され、前記再結晶化領域を選択的に除去することにより、前記凹凸形状を形成することを特徴とする請求項 6 記載のデバイスの製造方法。